慶應義塾大学試験問題 物理学 D (一斉)

20[6年1月22日(金)1時限(試験時間50分) 問題用紙 回収不要 担当者 神成、木下、齊藤、高野

注意:とくに指示がない場合、答案には結果のみならず、それを導いた過程についても記すこと。また、万一与えられた条件だけでは解けない場合には、適当な量を定義したり、条件を明記した上で解いてよい。電気定数 ϵ_0 、磁気定数 μ_0 、真空中の光速 c の記号は断りなしに使ってよい。

- 問題 I 真空中に、半径 a の導体 (金属) の球と、内半径 b、外半径 d の導体 (金属) の球殻が、中心が共通になるように配置されている (0 < a < b < d)。この共通の中心を位置ベクトル r の原点とする。即ち、中心からの距離 r = |r| が $0 \le r \le a$ の領域と $b \le r \le d$ の領域が導体 (金属) である。中心からの距離 r が $a \le r \le b$ の領域は誘電体で満たされており、その誘電率は中心からの距離 r の関数として、 $\varepsilon(r) = \bar{\varepsilon}\varepsilon_0 \left(\frac{b}{r}\right)^5$ で与えられている。ここで、 $\bar{\varepsilon}$ は $\bar{\varepsilon} > 1$ を満たす定数である。外側の導体 (金属) の球殻が帯電していない状態 (全電荷 0) で、内側の導体 (金属) の球に Q の電荷を与える。
 - (1) 位置r における電界E(r)、電東密度D(r)、電気分極P(r) を求めなさい。
 - (2) この系の静電エネルギー $U_{\rm E}$ を求めなさい。
 - (3) 誘電体の内側の表面上の位置 r(|r|=a) における分極電荷面密度 $\omega_P(r=a)$ 、誘電体の外側の表面上の位置 r(|r|=b) における分極電荷面密度 $\omega_P(r=b)$ 、誘電体内の位置 r における分
 - 極電荷密度 pp(r) を求めなさい。

ヒント: スカラー場 f(r)、ベクトル場 V(r) に対し、 $\operatorname{div}(fV) = \nabla \cdot (fV) = (\nabla f) \cdot V + f \nabla \cdot V = (\operatorname{grad} f) \cdot V + f \operatorname{div} V$

- 問題 II 物質中で、電界を E、電東密度を D、磁東密度を B、磁界を H、真電荷密度を ho_t 、真電流密度を i_t とする。
 - (1) 物質中のマクスウェル方程式を書きなさい。
 - (2) 物質が一様で、その誘電率 ε と透磁率 μ が一定の場合を考える。時刻 t、位置 r において $E(r,t)=E_0f(\hat{k}\cdot r-vt)$ 、 $B(r,t)=B_0f(\hat{k}\cdot r-vt)$ と表される平面電磁波を考える。ここで、 $f(\xi)$ は 2 回以上微分可能な任意の関数、 E_0 、 B_0 は定数ベクトル、 \hat{k} は定数の単位ベクトル、v は定数である。これがマクスウェル方程式を満たすには、v はどのような値でなければならないか書きなさい。また、 E_0 、 B_0 、 \hat{k} 、v の間にどのような関係がなければならないか書きなさい。いずれも解のみで良い。
 - (3) (2) の平面電磁波に対して、時刻 t、位置 r における電磁場のエネルギー密度 u(r,t) とポインティングベクトル S(r,t) を求めなさい。解は ε 、 μ 、 E_0 、f、 \hat{k} のみを用いて表しなさい。また、u、S、v、 \hat{k} の間の関係を書きなさい。



IN INCE